

電気学会研究会資料目次

電子材料研究会

テーマ「誘電体薄膜集積化プロセス」

〔委員長〕 奥村 次徳 (都立大)

〔幹事〕 岡田 至崇 (筑波大), 羽路 伸夫 (横浜国大)

日時 平成17年6月3日 (金) 9:50~16:40

場所 自動車会館 (市ヶ谷) 2階大会議室

EFM-05-22 high-k 膜の XPS による評価

野平博司, 服部健雄 (武蔵工業大学) 1

EFM-05-23 Y をドーブした HfO_2 の相変化による誘電率の上昇

喜多浩之, 弓野健太郎, 鳥海 明 (東京大学) 7

EFM-05-24 AC ストレス下の NBTI に及ぼす極薄 SiON 膜中窒素プロファイルの影響

三谷祐一郎, 松澤一也 (東芝) 13

EFM-05-25 キャリア分離法を用いた high-k stack ゲート絶縁膜のキャリア伝導及び絶縁性劣化機構の解析

水林 亘 (半導体 MIRAI-ASET, 産業技術総合研究所, ASRC)

安田直樹, 岡田健治 (半導体 MIRAI-ASET)

太田裕之, 堀川 剛 (半導体 MIRAI-ASET, 産業技術総合研究所, ASRC)

岩本邦彦, 生田目俊秀, 佐竹秀喜 (半導体 MIRAI-ASET)

鳥海 明 (半導体 MIRAI-ASET, 産業技術総合研究所, ASRC, 東京大学) 19

EFM-05-26 低スタンバイ電力用途 HfSiON トランジスタの高集積化

大塚文雄, 峰地 輝 (NEC エレクトロニクス)

田村泰之, 渡辺俊成, 佐々木隆興 (セイコーエプソン)

青山知憲 (東芝)

安平光雄 (松下電器産業)

有門経敏 (東京エレクトロン) 25

EFM-05-27 相制御 Ni フルシリサイド電極を用いた HfSiON 高誘電率ゲート絶縁膜 MOSFET の作製と電気特性の評価

高橋健介, 間部謙三, 五十嵐多恵子, 五十嵐信行, 長谷卓,

	吉原拓也, 渡部平司, 辰巳 徹, 望月康則 (NEC) ……………	31
EFM-05-28	HfSiON ゲート絶縁膜 CMOS の性能と信頼性における Hf 濃度の影響 渡辺 健, 高柳万里子 (東芝セミコンダクター社) ……………	37
EFM-05-29	ポーラスシリカの低誘電率絶縁膜への応用 藤井宣年, 中山高博, 高村一夫, 田中博文 (半導体 MIRAI-ASET) 清野 豊, 秦 信宏, 吉野雄信 (半導体 MIRAI-ASET, 産業技術総合研究所, ASRC) 吉川公麿 (半導体 MIRAI-ASET, 産業技術総合研究所, ASRC, 広島大学) ……………	43
EFM-05-30	130,90,65nm 及びそれ以降の多層配線技術における low-k 絶縁膜技術 宮島秀史, 渡邊 桂, 藤田敬次, 伊藤祥代, 秋山和隆, 蜂谷貴世, 東 和幸, 中村直文, 梶田明広, 松永範昭, 猪原正弘, 本多健二, 上條浩幸, 中田錬平, 矢野博之, 早坂伸夫, 柴田英毅, 依田 孝 (東芝) 田淵清隆, 島山 努, 榎本容幸, 金村龍一, 長谷川利昭, 門村新吾 (ソニー) ……………	47
EFM-05-31	HfAlO バッファ層を用いた強誘電体ゲート FET の電気的特性とバッファ層の製膜条件 との関係 高橋光恵, 堀内健史, 酒井滋樹 (産業技術総合研究所) ……………	51
EFM-05-32	YMnO ₃ /Y ₂ O ₃ /Si エピタキシャル MFIS 構造の誘電特性 藤村紀文, 原武耕平, 吉村 武 (大阪府立大学) ……………	57
EFM-05-33	ITO チャネルを用いた強誘電体ゲート薄膜トランジスタ 徳光永輔, 妹尾 賢, 宮迫毅明, 瀧 悦 (東京工業大学) ……………	63
EFM-05-34	強誘電体薄膜を用いた連想プロセッサ 小林大輔, 柴田 直 (東京大学) ……………	69